Esercizio A

- 1) È una porta logica tri-state e $OUT = An + (Bn * Cn) + (Dn * (Fn + Gn))$ dove n indica il negato
- 2)

- 3) Il caso peggiore si ha con tre Pmos in serie. Il $kequ = kp/3$ e si ha una prima carica del condensatore con il mos equivalente in saturazione e una seconda fase in cui il mos equivalente lavora in zona triodo. Il $T_{saturation} = |V_{tp}| * C / I_{sat} = 62.5$ ps mentre il T_{triode} si ottiene considerando la resistenza equivalente $\tau = R * C = (V_{ds_{sat}} / I_{sat}) * C = (250 \text{ ohm}) * C = 250$ ps e calcolandolo con l'equazione $(V_{dd} - |V_{tp}|)(1 - e^{-T_{triode}/\tau}) + |V_{tp}| = V_{dd}/2$, da cui si ottiene un $T_{triode} = 169.5$ ps. Il tempo totale per la commutazione è dato dalla somma dei due tempi precedentemente calcolati, **$T_{0-50\%} = 232$ ps**
- 4) Per $E=0$ la potenza dinamica dissipata è **nulla**, per $E=1$ invece **$P = V_{dd}^2 * C_{out} * f_{ck} = 25 \mu W$**

Esercizio B

- 1) Con ingresso nullo si ha $V_G = 0V$, $V_{GS} = -V_{OUT} = -V_{SS} - R_2 * I_D$ e il MOSFET sicuramente saturo ($V_{GD} = -5V$). Utilizzando la relazione quadratica tra I_D e V_{GS} si trova un'equazione che risolta fornisce **$V_{GS} = 1V$, $I_D = 0.5mA$, $V_{OUT} = -1V$ e $g_m = 2mS$** .
- 2) A bassa frequenza il condensatore è un aperto e il trasferimento è **$v_{out}/v_{in}|_{BF} = R_2 g_m / (1 + R_2 g_m) = 0.941$** . Ad alta frequenza il condensatore è un corto circuito imponendo una corrente di segnale nulla nel transistor. Di conseguenza l'uscita è determinata dalla partizione delle resistenze: **$v_{out}/v_{in}|_{AF} = R_2 / (R_1 + R_2) = 0.444$** .

- 3) Il circuito è con una singola costante di tempo determinata dalla resistenza equivalente R_{eq} vista da C. Per calcolare R_{eq} possiamo sostituire al condensatore un generatore di tensione test e valutare la corrente circolante in esso. Applicando la legge di Kirchoff delle tensioni alla maglia R1-v_{test}-R2 si ha: $-R_1 \cdot i_{test} + v_{test} + R_2 \cdot (g_m \cdot v_{test} - i_{test}) = 0$. Risolta fornisce $R_{eq} = v_{test}/i_{test} = (R_1 + R_2)/(1 + g_m R_2) = 1.059k\Omega$. Il transitorio della tensione di uscita è di tipo esponenziale con costante di tempo $\tau = C \cdot R_{eq} = 100.59ns$, valore iniziale $V_{OUT}(0^+) = -1V + v_{out}/v_{in}|_{AF} \cdot 100mV = -1V + 44.4mV = -0.956V$ e valore finale $V_{OUT}(\infty) = -1V + v_{out}/v_{in}|_{BF} \cdot 100mV = -1V + 94.1mV = -0.906V$
- 4) In continua v_{in} non dissipa potenza perché non circola corrente in esso. La potenza dissipata complessiva è quindi $P_d = (V_{DD} - V_{SS}) \cdot I_D$. Imponendo il valore di 10mW si trova $I_D = 1mA$ che implica una $V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_D}{k}} = 1.207V$ nell'ipotesi di MOS saturo. La tensione v_{in} deve valere di conseguenza: $v_{in} = V_{SS} + R_2 \cdot I_D + V_{GS} = 4.207V$ che soddisfa l'ipotesi di saturazione.

Esercizio C

- 1) Il trasferimento ideale è $V_{ADC}/I_{IN} = R_F = 5k\Omega$. Considerando il prodotto guadagno-banda finito dell'amplificatore operazionale il trasferimento ha un polo aggiuntivo alla frequenza in cui $|G_{loop}| = 1$. Dato che il guadagno d'anello coincide con $A(s)$ il **polo del trasferimento ad anello chiuso è a 10MHz**. Dato che la tensione in uscita dell'operazionale è compresa tra 0V e 5V il **MOSFET è sicuramente acceso** quando $V_S = 10V$. La presenza di C_H non cambia però il trasferimento grazie alla resistenza nulla di uscita dell'operazionale.
- 2) $V_{ADC, non\ idealità} = R_F \cdot I_B - R_1 \cdot I_{B+} + V_{OS} = 10mV$. $LSB = 10V/2^{10} = 9.77mV \rightarrow$ **errore = 1.024 LSB**
- 3) $Z_{IN} = R_F/(1 + A_0) = 5m\Omega$.
- 4) Il guadagno d'anello vale $G_{loop} = -A(s) \cdot \frac{1}{1 + sR_F C_{IN}}$. Il polo della rete di feedback è alla frequenza $f_p = 1/(2\pi R_F C_{IN}) = 31.8kHz$. Dato che la sua frequenza è molto più piccola del GBWP dell'operazionale esso interviene prima del taglio dell'asse a 0dB causando un **margin di fase circa nullo ($\phi_m = 3.5^\circ$)**.